

- Вт 4 Н.А. Байдакова, А.Н. Яблонский, А.В. Новиков, Д.В. Лобанов, М.В. Шалеев  
Исследование пространственно прямых излучательных переходов в структурах с Ge(Si) самоформирующимися островками
- Вт 5 Н.В. Байдусь, Б.Н. Звонков, В.А. Кукушкин, Д.С. Абрамкин  
Влияние поляризации излучения квантовых точек InAs/GaAs на свойства поверхностных плазмон-поляритонов
- Вт 6 П.А. Белёвский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, Н.В. Байдусь, Б.Н. Звонков  
Неустойчивости тока в селективно легированных n-InGaAs/GaAs гетеро-структурах с квантовыми ямами при латеральном электрическом транспорте
- Вт 7 Р.М. Балагула, М.Я. Винниченко, И.С. Махов, Д.А. Фирсов, Л.Е. Воробьев  
Модуляция межподзонного поглощения света и межзонной фотолюминесценции в двойных квантовых ямах GaAs/AlGaAs в сильных продольных электрических полях
- Вт 8 А.С. Большаков, В.В. Чалдышев, Е.Е. Заварин, А.В. Сахаров, В.В. Лундин, А.Ф. Цацульников  
Оптическая спектроскопия резонансных брэгговских структур с квантовыми ямами InGaN/GaN
- Вт 9 Г.В. Будкин, С.А. Тарасенко  
Эффект электронного хруповика в двумерных системах в условиях циклотронного резонанса
- Вт 10 А.Д. Буравлев, И.В. Илькив, Р.Р. Резник, И.В. Штром, И.П. Сошников, А.И. Хребтов, Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин  
Формирование одномерных GaAs нитевидных нанокристаллов
- Вт 11 П.А. Бушуйкин, Д.Н. Лобанов, А.Н. Яблонский, В.Ю. Давыдов, Б.А. Андреев  
Особенности фотопроводимости нитрида индия
- Вт 12 Н.С. Волкова, А.П. Горшков, В.О. Догадин, Л.А. Истомин, С.Б. Левичев  
Температурные зависимости эффективности эмиссии носителей заряда из квантовых точек InAs/GaAs
- Вт 13 А.В. Галеева, С.Г. Егорова, В.И. Черничкин, В.В. Румянцев, С.В. Морозов, М.Е. Тамм, Л.В. Яшина, Н. Plank, С.Н. Данилов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов  
Электронные поверхностные состояния в топологических изоляторах  $(\text{Bi}_{1-x}\text{In}_x)_2\text{Se}_3$  и  $\text{Pb}_{1-y}\text{Sn}_y\text{Se}$  под действием терагерцового лазерного излучения
- Вт 14 В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, Д.М. Гапонова, З.Ф. Красильник, Д.И. Крыжков, К.С. Журавлев  
Оптическая диагностика процессов экситонного возбуждения и релаксации в низкоразмерных полупроводниковых гетероструктурах с квантовыми ямами
- Вт 15 С.М. Некоркин, Б.Н. Звонков, Н.В. Дикарева, В.Я. Алешкин, А.А. Дубинов  
Перестройка волноводных мод в многоярном гетеролазере
- Вт 16 А.А. Дубинов  
Диодные "спазеры" на основе  $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}/\text{InP}$  и  $n^{++} - \text{Ge}$
- Вт 17 А.В. Ершов, Д.А. Грачев, А.М. Легков, А.Н. Яблонский, Б.А. Андреев  
Люминесцентные свойства многослойных структур «нанокристаллический кремний/диэлектрик», подвергнутых термообработке в водороде
- Вт 18 М.Ю. Есин, А.И. Никифоров, В.А. Тимофеев, В.И. Машанов, А.Р. Туктамышев, О.П. Пчеляков  
Влияние фонового содержания Sn на формирование Ge островков на поверхности Si(100)
- Вт 19 М.С. Жолудев  
Гамильтониан ориентацией в
- Вт 20 Р.Х. Жукавин, К. Н.-W. Hübers, N. Акцепторы в к
- Вт 21 К.А. Иванов, М. Ангармоническ смешённых свет
- Вт 22 А.В. Иконников, В.И. Гавриленко  
Циклотронный InAs/GaSb
- Вт 23 О.А. Клименко, В.И. Егоркин, Н. Детектирование канала InAlAs/In сопоставлении с
- Вт 24 К.А. Ковалевский  
Влияние одноос доноров в крем
- Вт 25 Н.В. Байдусь, С.А. А.В. Ершов, А.В. Импульсный In областью и узко
- Вт 26 А.Н. Косарев, В.И. М.А. Путьато, Б.Р. Влияние нановк GaAs
- Вт 27 Е.Р. Кочаровская  
Сверхизлучающ связью волн. Ан релаксации пол
- Вт 28 В.С. Багаев, А.С. Анализ состояни гетероструктур
- Вт 29 Д.Ф. Аминев, В.С. А.В. Новиков  
Тушение люмин действием балли
- Вт 30 К.Е. Кудрявцев, Е. Формирование в микроструктур
- Вт 31 К.В. Маремьянин, И.И. Засавицкий, Терагерцовые на длиной волны из